



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HP32CF

对应国外型号
TIP32C

主要用途

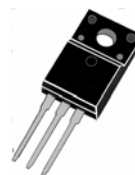
中功率线性开关

极限值 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

T_{stg}	贮存温度	$-55\sim 150^{\circ}\text{C}$
T_j	结温	150°C
P_C	集电极功率耗散 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	30W
P_C	集电极功率耗散 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)	2W
V_{CBO}	集电极—基极电压	-100V
V_{CEO}	集电极—发射极电压	-100V
V_{EBO}	发射极—基极电压	-5V
I_C	集电极电流 (DC)	-3A
I_C	集电极电流 (脉冲)	-5A
I_B	基极电流	-1A

外形图及引脚排列

TO-220F



- 1—基 极, B
2—集电极, C
3—发射极, E

电参数 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CEO} (SUS)	集电极—发射极维持电压*	-100			V	$I_C=-30\text{mA}$, $I_B=0$
I_{CEO}	集电极—发射极截止电流			-0.3	mA	$V_{\text{CE}}=-60\text{V}$, $I_B=0$
I_{CES}	集电极—发射极截止电流			-0.2	mA	$V_{\text{CE}}=-100\text{V}$, $V_{\text{EB}}=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-1	mA	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}$, $I_C=0$
H_{FE} (1)	直流电流增益*	25				$V_{\text{CE}}=-4\text{V}$, $I_C=-1\text{A}$
H_{FE} (2)		10		50		$V_{\text{CE}}=-4\text{V}$, $I_C=-3\text{A}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压*			-1.2	V	$I_C=-3\text{A}$, $I_B=-375\text{mA}$
$V_{\text{BE(on)}}$	基极—发射极导通电压*			-1.8	V	$V_{\text{CE}}=-4\text{V}$, $I_C=-3\text{A}$
f_T	特征频率	3.0			MHz	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_C=-0.5\text{A}$,

*脉冲测试: 脉宽 $\leq 300\mu\text{s}$, 占空比 $\leq 2\%$ 。



汕头华汕电子器件有限公司

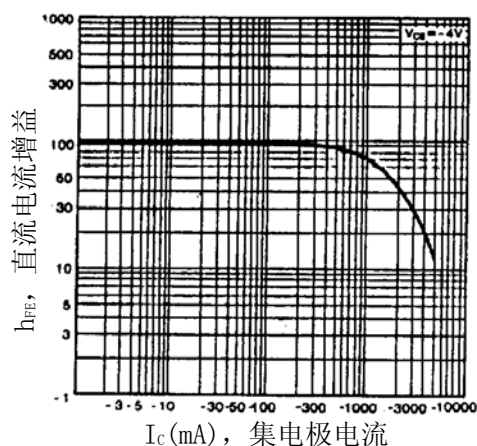
PNP SILICON TRANSISTOR

HP32CF

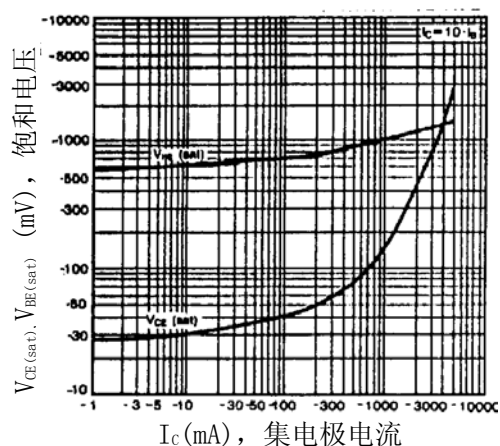
对应国外型号
TIP32C

■ 典型特性曲线 (除非另有说明, $T_a=25^\circ\text{C}$)

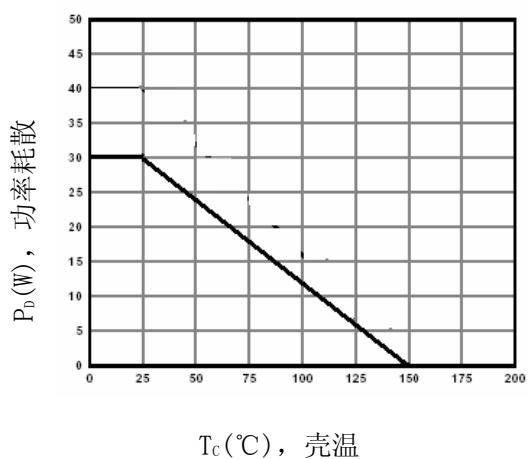
直流电流增益



基极-发射极饱和电压
集电极-发射极饱和电压



功率降额



安全工作区

